WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 33/00, H01S 3/19

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/12757

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

26. März 1998 (26.03.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/02139

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. September 1997

(22.09.97)

A1

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(30) Prioritätsdaten:

196 38 667.5

20. September 1996 (20.09.96) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder: und

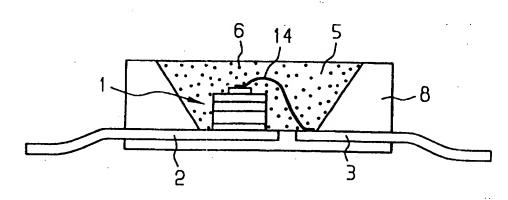
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÖHN, Klaus [DE/DE]; Pater-Rupert-Mayer-Weg 5, D-82024 Taufkirchen (DE). DEBRAY, Alexandra [DE/DE]; Grünbeckstrasse 8. D-93049 Regensburg (DE). SCHLOTTER, Peter [DE/DE]; Kammertalstrasse 8A, D-79113 Freiburg (DE). SCHMIDT, Ralf [DE/DE]; Mühlenstrasse 14, D-79279 Vörstetten (DE). SCHNEIDER, Jürgen [DE/DE]; Neuhaeuser Strasse 62, D-79199 Kirchzarten (DE).

(54) Title: SEALING MATERIAL WITH WAVELENGTH CONVERTING EFFECT, APPLICATION AND PRODUCTION PROCESS

(54) Bezeichnung: WELLENLÄNGENKONVERTIERENDE VERGUSSMASSE, DEREN VERWENDUNG UND VERFAHREN ZU **DEREN HERSTELLUNG**

(57) Abstract

present The invention pertains to a sealing material (5) with wavelength converting effect, obtained by mixing epoxy cast resin with a luminescent substance and intended for use in electroluminescent building component comprising a body (1) emitting an ultraviolet light, blue or green, and spraying in the epoxy cast resin a powder of



inorganic luminescent pigments (6) from the phosphor group of general formula A₃B₅X₁₂:M, with a grain size ≤10 µm and a grain diameter d₅₀ ≤5 µm.

(57) Zusammenfassung

Wellenlängenkonvertierende Vergußmasse (5) auf der Basis eines transparenten Epoxidgießharzes, das mit einem Leuchtstoff versetzt ist, für ein elektrolumineszierendes Bauelement mit einem ultraviolettes, blaues oder grünes Licht aussendenden Körper (1). Im transparenten Epoxidgießharz ist ein anorganisches Leuchtstoffpigmentpulver mit Leuchtstoffpigmenten (6) aus der Gruppe der Phosphore mit der allgemeinen Formel A₃B₅X₁₂:M dispergiert und die Leuchtstoffpigmente weisen Komgrö8en ≤10 µm und einen mittleren Komdurchmesser $d_{50} \leq 5 \mu m$ auf.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ.	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschiklstan .
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkci
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	ŲG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vor
CA	Kanada.	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika .
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL.	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	Li	Liechtenstein	·SD	Sudan	an .	
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		•
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

1

Beschreibung

Wellenlängenkonvertierende Vergußmasse, deren Verwendung und Verfahren zu deren Herstellung

5

10

15

20

Die Erfindung betrifft eine wellenlängenkonvertierende Vergußmasse auf der Basis eines transparenten Epoxidgießharzes, das
mit einem Leuchtstoff versetzt ist, insbesondere für die Verwendung bei einem elektrolumineszierenden Bauelement mit einem
ultraviolettes, blaues oder grünes Licht aussendenden Körper.

Ein derartiges Bauelement ist beispielsweise aus der Offenlegungsschrift DE 38 04 293 bekannt. Darin ist eine Anordnung mit
einer Elektrolumineszenz- oder Laserdiode beschrieben, bei der
das von der Diode abgestrahlte Emmissionsspektrum mittels eines
mit einem fluoreszierenden, lichtwandelnden organischen Farbstoff versetzten Elements aus Kunststoff zu größeren Wellenlängen hin verschoben wird. Das von der Anordnung abgestrahlte
Licht weist dadurch eine andere Farbe auf als das von der
Leuchtdiode ausgesandte. Abhängig von der Art des dem Kunststoff beigefügten Farbstoffes lassen sich mit ein und demselben
Leuchtdiodentyp Leuchtdiodenanordnungen herstellen, die in unterschiedlichen Farben leuchten.

25

In vielen potentiellen Anwendungsgebieten für Leuchtdioden, wie zum Beispiel bei Anzeigeelementen im Kfz-Armaturenbereich, Beleuchtung in Flugzeugen und Autos und bei vollfarbtauglichen LED-Displays, tritt verstärkt die Forderung nach Leuchtdiodenanordnungen auf, mit denen sich mischfarbiges Licht, insbesondere weißes Licht erzeugen läßt.

30

Die bislang bekannten Vergußmassen der eingangs genannten Art mit organischen Leuchtstoffen zeigen bei Temperatur- und Temperatur-Feuchtebeanspruchung jedoch eine Verschiebung des Farbor-

2

tes, also des Farbe des vom elektrolumineszierenden Bauelement abgestrahlten Lichtes.

5

10

15

20

25

30

35

In JP-07 176 794-A ist eine weißes Licht aussendende planare Lichtquelle beschrieben, bei der an einer Stirnseite einer transparenten Platte zwei blaues Licht emittierende Dioden angeordnet sind, die Licht in die transparente Platte hinein aussenden. Die transparente Platte ist auf einer der beiden einander gegenüberliegenden Hauptflächen mit einer fluoreszierenden Substanz beschichtet, die Licht emittiert, wenn sie mit dem blauen Licht der Dioden angeregt wird. Das von der fluoreszierenden Substanz emittierte Licht hat eine andere Wellenlänge als das von den Dioden emittierte blaue Licht. Bei diesem bekannten Bauelement ist es besonders schwierig, die fluoreszierende Substanz in einer Art und Weise aufzubringen, daß die Lichtquelle homogenes weißes Licht abstrahlt. Darüber hinaus bereitet auch die Reproduzierbarkeit in der Massenfertigung große Probleme, weil schon geringe Schichtdickenschwankungen der fluoreszierenden Schicht, z. B. aufgrund von Unebenheiten der Oberfläche der transparenten Platte, eine Änderung des Weißtones des abgestrahlten Lichtes hervorruft.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vergußmasse der eingangs genannten Art zu entwickeln, mit der elektrolumineszierende Bauelemente hergestellt werden können, die homogenes mischfarbiges Licht abstrahlen und die eine Massenfertigung mit vertretbarem technischen Aufwand und mit weitestgehend reproduzierbarer Bauelementcharakteristik ermöglicht. Das abgestrahlte Licht soll auch bei Temperatur- und Temperatur-Feuchtebeanspruchung farbstabil sein. Desweiteren soll ein Verfahren zum Herstellen dieser Vergußmasse angegeben werden.

Diese Aufgabe wird durch eine Vergußmasse mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Verwen-

3

dungen der Vergußmasse sind Gegenstand der Unteransprüche 2 bis 11 bzw. 12 bis 16.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß im transparenten Epoxidgießharz ein anorganisch-mineralisches Leuchtstoffpigmentpulver auf der Basis eines Granatwirtsgitters mit der allgemeinen Formel $A_3B_5X_{12}$:M dispergiert sind und daß die Leuchtstoffpigmente Korngrößen \leq 20 μ m und einen mittleren Korndurchmesser $d_{50} \leq 5$ μ m aufweisen. Besonders bevorzugt liegt der mittlere Korndurchmesser d_{50} zwischen 1 und 2 μ m. Bei diesen Korngrößen können günstige Fertigungsausbeuten erhalten werden.

Anorganisch-mineralische Leuchtstoffe sind vorteilhafterweise äußerst temperatur- und temperatur-feuchtestabil.

15

10

. 5

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vergußmasse setzt sich diese zusammen aus:

- a) Epoxidgießharz ≥ 60 Gew%
- b) Leuchtstoffpigmente ≤ 25 Gew%
- 20 c) Thixotropiermittel ≤ 10 Gew%
 - d) mineralischem Diffusor ≤ 10 Gew%
 - e) Verarbeitungshilfsmittel ≤ 3 Gew%
 - f) Hydrophobiermittel ≤ 3 Gew%
 - q) Haftvermittler ≤ 2 Gew%.

25

30

Geeignete Epoxidgießharze sind beispielsweise in der DE-OS 26 42 465 auf den Seiten 4 bis 9, insbesondere Beispiele 1 bis 4, und in der EP 0 039 017 auf den Seiten 2 bis 5, insbesondere Beispiele 1 bis 8, beschrieben, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.

Als Thixotropiermittel ist beispielsweise pyrogene Kieselsäure verwendet. Das Thixotropiermittel dient zur Eindickung des Epoxidgießharzes, um die Sedimentation des Leuchtpigmentpulvers

4

zu vermindern. Für die Gießharzverarbeitung werden weiter die Fließ- und Benetzungseigenschaften eingestellt.

Als mineralischer Diffusor zur Optimierung des Leuchtbildes des Bauelements ist bevorzugt CaF₂ verwendet.

Als Verarbeitungshilfsmittel eignet sich beispielsweise Glykolether. Es verbessert die Verträglichkeit zwischen Epoxidgießcharz und Leuchtpigmentpulver und dient damit zur Stabilisierung der Dispersion Leuchtpigmentpulver - Epoxidgießharz. Zu diesem Zweck können auch Oberflächenmodifikatoren auf Silikonbasis eingesetzt werden.

Das Hydrophobiermittel, z. B. flüssiges Silikonwachs, dient ebenfalls zur Modifikation der Pigmentoberfläche, insbesondere wird die Verträglichkeit und Benetzbarkeit der anorganischen Pigmentoberfläche mit dem organischen Harz verbessert.

Der Haftvermittler, z. B. funktionelles Alkoxysiloxan, verbessert die Haftung zwischen den Pigmenten und dem Epoxidharz im ausgehärteten Zustand der Vergußmasse. Dadurch wird erreicht, daß die Grenzfläche zwischen dem Epoxidharz und den Pigmenten z. B. bei Temperaturschwankungen nicht abreißt. Spalte zwischen dem Epoxidharz und den Pigmenten würden zu Lichtverlusten im Bauelement führen.

Das Epoxidgießharz, bevorzugt mit einem reaktiven Oxirandreiring, enthält vorzugsweise ein mono- und/oder ein mehrfunktionelles Epoxidgießharzsystem (≥ 80 Gew%; z. B. Bisphenol-A30 Diglycidylether), einen Reaktivverdünner (≤ 10 Gew%; z. B. aromatischer Monoglycidylether), einen mehrfunktionellen Alkohol
(≤ 5 Gew%), ein Entgasungsagens auf Silikonbasis (≤ 1 Gew%) und
eine Entfärbungskomponente zur Einstellung der Farbzahl (≤ 1
Gew%).

5

10

15

20

5

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung des Vergusses sind die Leuchtstoffpigmente kugelförmig oder schuppenförmig. Die Neigung zur Agglomeratbildung derartiger Pigmente ist vorteilhafterweise sehr gering. Der $\rm H_2O$ -Gehalt liegt unter 2%.

5

10

15

20

25

Bei der Herstellung und Verarbeitung von Epoxidgießharzkomponenten mit anorganischen Leuchtstoffpigmentpulvern treten im allgemeinen neben Benetzungs- auch Sedimentationsprobleme auf. Besonders Leuchtstoffpigmentpulver mit $d_{50} \leq 5 \mu m$ neigen stark zur Agglomeratbildung. Bei der zuletzt genannten Zusammensetzung der Vergußmasse können die Leuchtstoffpigmente vorteilhafterweise in der oben angegebenen Korngröße im Wesentlichen agglomeratfrei und homogen in das Epoxidgießharz dispergiert werden. Diese Dispersion ist auch bei längerer Lagerung der Vergußmasse stabil. Es treten im Wesentlichen keine Benetzungsund/oder Sedimentationsprobleme auf.

Besonders bevorzugt sind als Leuchtstoffpigmente Partikel aus der Gruppe der Ce-dotierten Granate, insbesondere YAG:Ce-partikel verwendet. Eine vorteilhafte Dotierstoffkonzentration ist beispielsweise 1% und eine vorteilhafte Leuchtstoffkonzentration beträgt beispielsweise 12%. Desweiteren weist das bevorzugt hochreine Leuchtstoffpigmentpulver vorteilhafterweise einen Eisengehalt von ≤ 5ppm auf. Ein hoher Eisengehalt führt zu hohen Lichtverlusten im Bauelement. Das Leutstoffpigmentpulver ist stark abrasiv. Der Fe-Gehalt der Vergußmasse kann bei deren Herstellung daher beträchtlich ansteigen. Vorteilhaft sind Fe-Gehalte in der Vergußmasse < 20ppm.

Der anorganische Leuchtstoff YAG:Ce hat unter anderem den besonderen Vorteil, daß es sich hierbei um nicht lösliche Farbpigmente mit einem Brechungsindex von ca. 1,84 handelt. Dadurch treten neben der Wellenlängenkonversion Dispersion und Streueffekte auf, die zu einer guten Vermischung von blauer Diodenstrahlung und gelber Konverterstrahlung führen. Besonders vorteilhaft ist weiterhin, dass die Leuchtstoffkonzentration im Epoxidharz bei Verwendung von anorganischen Leuchtstoffpigmenten nicht, wie bei organischen Farbstoffen, durch die Löslichkeit begrenzt wird.

Zur weiteren Verminderung der Agglomeratbildung können die Leuchtstoffpigmente vorteilhafterweise mit einem Silikon-Coating versehen sein.

10

15

20

25

30

5

Bei einem bevorzugten Verfahren zum Herstellen einer erfindungsgemäßen Vergußmasse wird das Leuchtstoffpigmentpulver vor dem Vermischen mit dem Epoxidgießharz z. B. ca. 10 Stunden bei einer Temperatur ≥ 200°C getempert. Dadurch kann ebenfalls die Neigung zu Agglomeratbildung verringert werden.

Alternativ oder zusätzlich kann dazu das Leuchtstoffpigmentpulver vor dem Vermischen mit dem Epoxidgießharz in einem höher siedenden Alkohol geschlämmt und anschließend getrocknet wird. Eine weitere Möglichkeit die Agglomeratbildung zu verringern besteht darin, dem Leuchtstoffpigmentpulver vor dem Vermischen mit dem Epoxidgießharz ein hydrophobierendes Silikonwachs zuzugeben. Besonders vorteilhaft ist die Oberflächenstabilisierung der Phosphore durch erwärmen der Pigmente in Gegenwart von Glykolethern, z. B. 16 h bei T > 60°C.

Zur Vermeidung störender Verunreinigungen beim Dispergieren der Leuchstoffpigmente, verursacht durch Abrieb, werden Reaktionsgefäße, Rühr- und Dispergiervorrichtungen sowie Walzwerke aus Glas, Korund, Carbid- und Nitridwerkstoffen sowie speziell gehärtete Stahlsorten verwendet. Agglomeratfreie Leuchtstoffdispersionen werden auch in Ultraschallverfahren oder durch den Einsatz von Sieben und Glaskeramikfritten erhalten.

7

Ein besonders bevorzugter anorganischer Leuchtstoff zur Herstellung von Weiß leuchtenden optoelektronischen Bauelementen ist der Phosphor YAG:Ce $(Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+})$. Dieser läßt sich auf besonders einfache Weise in herkömmlich in der LED-Technik verwendeten transparenten Epoxidgießharzen mischen. Weiterhin als Leuchtstoffe denkbar sind weitere mit Seltenen Erden dotierte Granate wie z. B. $Y_3Ga_5O_{12}:Ce^{3+}$, $Y(Al,Ga)_5O_{12}:Ce^{3+}$ und $Y(Al,Ga)_5O_{12}:Tb^{3+}$.

- 2ur Erzeugung von mischfarbigem Licht eignen sich darüberhinaus besonders die mit Seltenen Erden dotierten Thiogallate wie z. B. CaGa₂S₄:Ce³⁺ und SrGa₂S₄:Ce³⁺. Ebenso ist hierzu die Verwendung von mit Seltenen Erden dotierten Aluminaten wie z. B. YA-10₃:Ce³⁺, YGaO₃:Ce³⁺, Y(Al,Ga)O₃:Ce³⁺ und mit Seltenen Erden dotierten Orthosilikaten M₂SiO₅:Ce³⁺ (M: Sc, Y, Sc) wie z. B. Y₂SiO₅:Ce³⁺ denkbar. Bei allen Yttriumverbindungen kann das Yttrium im Prinzip auch durch Scandium oder Lanthan ersetzt werden.
- Bevorzugt wird die erfindungsgemäße Vergußmasse bei einem 20 strahlungsemittierenden Halbleiterkörper, insbesondere mit einer aktiven Halbleiterschicht oder -schichtenfolge aus GaxIn1.xN oder $Ga_{\mathbf{x}}Al_{1-\mathbf{x}}N$, eingesetzt, der im Betrieb eine elektromagnetische Strahlung aus dem ultravioletten, blauen und/oder grünen Spektralbereich aussendet. Die Leuchtstoffpartikel in der Ver-25 gußmasse wandeln einen Teil der aus diesem Spektralbereich stammenden Strahlung in Strahlung mit größerer Wellenlänge um, derart, daß das Halbleiterbauelement Mischstrahlung, insbesondere mischfarbiges Licht, bestehend aus dieser Strahlung und aus Strahlung aus dem ultravioletten, blauen und/oder grünen 30 Spektralbereich aussendet. Das heißt beispielsweise, daß die Leuchtstoffpartikel einen Teil der vom Halbleiterkörper ausgesandten Strahlung spektral selektiv absorbiert und im längerwelligen Bereich emittiert. Bevorzugt weist die von dem Halbleiterkörper ausgesandte Strahlung bei einer Wellenlänge $\lambda \leq$ 35

8

520 nm ein relatives Intensitätsmaximum auf und liegt der von den Leuchtstoffpartikeln spektral selektiv absorbierte Wellenlängenbereich außerhalb dieses Intensitätsmaximums.

Ebenso können vorteilhafterweise auch mehrere verschiedenartige Leuchtstoffpartikelarten, die bei unterschiedlichen Wellenlängen emittieren, in der Vergußmasse dispergiert sein. Dies wird bevorzugt duruch unterschiedliche Dotierungen in unterschiedlichen Wirtsgittern erreicht. Dadurch ist es vorteilhafterweise möglich, vielfältige Farbmischungen und Farbtemperaturen des vom Bauelement emittierten Lichtes zu erzeugen. Von besonderem Interesse ist dies für vollfarbtaugliche LEDs.

15

20

25

30

35

Bei einer bevorzugten Verwendung der erfindungsgemäßen Vergußmasse ist ein strahlungsemittierender Halbleiterkörper (z. B. ein LED-Chip) zumindest teilweise von dieser umschlossen. Die Vergußmasse ist dabei bevorzugt gleichzeitig als Bauteilumhüllung (Gehäuse) genutzt. Der Vorteil eines Halbleiterbauelements gemäß dieser Ausführungsform besteht im wesentlichen darin, daß zu seiner Herstellung konventionelle, für die Herstellung von herkömmlichen Leuchtdioden (z. B. Radial-Leuchdioden) eingesetzte Produktionslinien verwendet werden können. Für die Bauteilumhüllung wird anstelle des bei herkömmlichen Leuchtdioden dafür verwendeten transparenten Kunststoffes einfach die Vergußmasse verwendet.

Mit der erfindungsgemäßen Vergußmasse kann auf einfache Weise mit einer einzigen farbigen Lichtquelle, insbesondere einer Leuchtdiode mit einem einzigen blaues Licht abstrahlenden Halbleiterkörper, mischfarbiges, insbesondere weißes Licht erzeugt werden. Um z. B. mit einem blaues Licht aussendenden Halbleiterkörper weißes Licht zu erzeugen, wird ein Teil der von dem Halbleiterkörper ausgesandten Strahlung mittels anorganischer Leuchtstoffpartikel aus dem blauen Spektralbereich in den zu Blau komplementärfarbigen gelben Spektralbereich konvertiert.

9

Die Farbtemperatur oder Farbort des weißen Lichtes kann dabei durch geeignete Wahl des Leuchtstoffes, dessen Partikelgröße und dessen Konzentration, variiert werden. Darüber hinaus können auch Leuchtstoffmischungen eingesetzt werden, wodurch sich vorteilhafterweise der gewünschte Farbton des abgestrahlten Lichtes sehr genau einstellen läßt.

Besonders bevorzugt wird die Vergußmasse bei einem strahlungsemittierenden Halbleiterkörper verwendet, bei dem das ausgesandte Strahlungsspektrum bei einer Wellenlänge zwischen 420nm und 460 nm, insbesondere bei 430 nm (z. B. Halbleiterkörper auf der Basis von Ga_xAl_{1-x}N) oder 450 nm (z. B. Halbleiterkörper auf der Basis von Ga_xIn_{1-x}N) ein Intensitätsmaximum aufweist. Mit einem derartigen Halbleiterbauelement lassen sich vorteilhafterweise nahezu sämtliche Farben und Mischfarben der C.I.E.-Farbtafel erzeugen. An Stelle des strahlungsemittierenden Halbleiterkörpers aus elektrolumineszierendem Halbleitermaterial kann aber auch ein anderes elektrolumineszierendes Material, wie beispielsweise Polymermaterial, eingesetzt werden.

20

25

30

35

10

15

Besonders geeignet ist die Vergußmasse für ein lichtemittierendes Halbleiterbauelement (z. B. eine Leuchtdiode), bei dem der elektrolumineszierende Halbleiterkörper in einer Ausnehmung eines vorgefertigten eventuell bereits mit einem Leadframe versehenen Gehäuses angeordnet ist und die Ausnehmung mit der Vergußmasse versehen ist. Ein derartiges Halbleiterbauelement läßt sich in großer Stückzahl in herkömmlichen Produktionslinien herstellen. Hierzu muß lediglich nach der Montage des Halbleiterkörpers in das Gehäuse die Vergußmasse in die Ausnehmung gefüllt werden.

Ein weißes Licht abstrahlendes Halbleiterbauelement läßt sich mit der erfindungsgemäßen Vergußmasse vorteilhafterweise dadurch herstellen, daß der Leuchtstoff so gewählt wird, daß eine von dem Halbleiterkörper ausgesandte blaue Strahlung in komple-

10

15

20

25

30

mentäre Wellenlängenbereiche, insbesondere Blau und Gelb, oder zu additiven Farbtripeln, z. B. Blau, Grün und Rot umgewandelt wird. Hierbei wird das gelbe bzw. das grüne und rote Licht über die Leuchtstoffe erzeugt. Der Farbton (Farbort in der CIE-Farbtafel) des dadurch erzeugten weißen Lichts kann dabei durch geeignete Wahl des/der Leuchtstoffes/e hinsichtlich Mischung und Konzentration variiert werden.

Um die Durchmischung der von einem elektrolumineszierenden Halbleiterkörper ausgesandten Strahlung mit der vom Leuchtstoff konvertierten Strahlung und damit die Farbhomogenität des vom Bauelement abgestrahlten Lichtes zu verbessern, ist bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vergußmasse zusätzlich ein im Blauen lumineszierender Farbstoff zugefügt, der eine sogenannte Richtcharakteristik der von dem Halbleiterkörper ausgesandten Strahlung abschwächt. Unter Richtcharakteristik ist zu verstehen, daß die von dem Halbleiterkörper ausgesandte Strahlung eine bevorzugte Abstrahlrichtung aufweist.

Ein weißes Licht abstrahlendes erfindungsgemäßes Halbleiterbauelement mit einem blaues Licht emittierenden elektrolumineszierenden Halbleiterkörper läßt sich besonders bevorzugt dadurch realisieren, daß dem für die Vergußmasse verwendeten Epoxidharz der anorganische Leuchtstoff YAG:Ce (Y₃Al₅O₁₂:Ce³⁺) beigemischt ist. Ein Teil einer von dem Halbleiterkörper ausgesandten blauen Strahlung wird von dem anorganischen Leuchtstoff Y₃Al₅O₁₂:Ce³⁺ in den gelben Spektralbereich und somit in einen zur Farbe Blau komplementärfarbigen Wellenlängenbereich verschoben. Der Farbton (Farbort in der CIE-Farbtafel) des weißen Lichts kann dabei durch geeignete Wahl der Farbstoffkonzentration variiert werden.

Der Vergußmasse können zusätzlich lichtstreuende Partikel, sogenannte Diffusoren zugesetzt sein. Hierdurch läßt sich vor-

11

teilhafterweise der Farbeindruck und die Abstrahlcharakteristik des Halbleiterbauelements weiter optimieren.

Mit der erfindungsgemäßen Vergußmasse kann vorteilhafterweise auch eine von einem elektrolumineszierenden Halbleiterkörper neben der sichtbaren Strahlung ausgesandte ultraviolette Strahlung in sichtbares Licht umgewandelt werden. Dadurch wird die Helligkeit des vom Halbleiterkörper ausgesandten Lichts deutlich erhöht.

10

20

Ein besonderer Vorteil von erfindungsgemäßen weißes Licht abstrahlenden Halbleiterbauelementen, bei denen als Lumineszenzkonversionsfarbstoff insbesondere YAG:Ce verwendet ist, besteht darin, daß dieser Leuchtstoff bei Anregung mit blauem Licht eine spektrale Verschiebung von ca. 100 nm zwischen Absorption und Emission bewirkt. Dies führt zu einer wesentlichen Reduktion der Reabsorption des vom Leuchtstoff emittierten Lichtes und damit zu einer höheren Lichtausbeute. Außerdem besitzt YAG:Ce vorteilhafterweise eine hohe thermische und photochemische (z. B. UV-) Stabilität (wesentlich höher als organische Leuchtstoffe), so daß auch Weiß leuchtende Dioden für Außenanwendung und/oder hohe Temperaturbereiche herstellbar sind.

YAG:Ce hat sich bislang hinsichtlich Reabsorption, Lichtausbeute, thermischer und photochemischer Stabilität und Verarbeitbarkeit als am besten geeigneter Leuchtstoff herausgestellt. Denkbar ist jedoch auch die Verwendung von anderen Ce-dotierten Phosphoren, insbesondere Ce-dotierten Granattypen.

Die Wellenlängenkonversion der Primärstrahlung wird durch die Kristallfeldaufspaltung der aktiven Übergangsmetallzentren im Wirtsgitter bestimmt. Durch die Substitution von Y durch Gd und/oder Lu bzw. Al durch Ga im Y₃Al₅O₁₂-Granatgitter können die Emissionswellenlängen in unterschiedlicher Weise verschoben werden, wie außerdem durch die Art der Dotierung. Durch die

5

10

15

30

35

Substitution von Ce³⁺-Zentren durch Eu³⁺ und/oder Cr³⁺ können entsprechende Shifts erzeugt werden. Entsprechende Dotierungen mit Nd³⁺ und Er³⁺ ermöglichen sogar aufgrund der größeren Ionenradien und damit geringeren Kristallfeldaufspaltungen IR-emittierende Bauelemente.

Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von zwei Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren 1 bis8. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines ersten Halbleiterbauelements mit einer erfindungsgemäßen Vergußmasse;
Figur 2 eine schematische Schnittansicht eines zweiten Halbleiterbauelements mit einer erfindungsgemäßen Vergußmasse;
Figur 3 eine schematische Schnittansicht eines dritten Halbleiterbauelements mit einer erfindungsgemäßen Vergußmasse;
Figur 4 eine schematische Schnittansicht eines vierten Halbleiterbauelements mit einer erfindungsgemäßen Vergußmasse;
Figur 5 eine schematische Schnittansicht eines fünften Halbleiterbauelements mit einer erfindungsgemäßen Vergußmasse;

Figur 5 eine schematische Schnittansicht eines fünften Halbleiterbauelements mit einer erfindungsgemäßen Vergußmasse;
Figur 6 eine schematische Darstellung eines Emissionsspektrums eines blaues Licht abstrahlenden Halbleiterkörpers mit einer Schichtenfolge auf der Basis von GaN;

25 Figur 7 eine schematische Darstellung der Emissionsspektren zweier Halbleiterbauelemente mit einer erfindungsgemäßen Vergußmasse, die weißes Licht abstrahlen, und Figur 8 eine schematische Darstellung der Emissionsspektren von weiteren Halbleiterbauelementen, die weißes Licht abstrahlen.

In den verschiedenen Figuren sind gleiche bzw. gleichwirkende Teile immer mit denselben Bezugszeichen bezeichnet.

Bei dem lichtemittierenden Halbleiterbauelement von Figur 1 ist der Halbleiterkörper 1 mittels eines elektrisch leitenden Ver-

bindungsmittels, z. B. ein metallisches Lot oder ein Klebstoff, mit seinem Rückseitenkontakt 11 auf einem ersten elektrischen Anschluß 2 befestigt. Der Vorderseitenkontakt 12 ist mittels eines Bonddrahtes 14 mit einem zweiten elektrischen Anschluß 3 verbunden.

5

10

30

35

Die freien Oberflächen des Halbleiterkörpers 1 und Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse 2 und 3 sind unmittelbar von einer gehärteten, wellenlängenkonvertierenden Vergußmasse 5 umschlossen. Diese weist bevorzugt auf: Epoxidgießharz 80 - 90 Gew%, Leuchtstoffpigmente (YAG:Ce) \leq 15 Gew%, Diethylenglycolmonomethylether \leq 2 Gew%, Tegopren 6875-45 \leq 2 Gew%, Aerosil 200 \leq 5 Gew%

Das in Figur 2 dargestellte Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements unterscheidet sich von dem der Figur 1 dadurch, daß der Halbleiterkörper 1 und Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse 2 und 3 anstatt von einer wellenlängenkonvertierenden Vergußmasse von einer transparenten Umhüllung 15 umschlossen sind. Diese transparente Umhüllung 15 bewirkt keine Wellenlängenänderung der von dem Halbleiterkörper 1 ausgesandten Strahlung und besteht beispielsweise aus einem in der Leuchtdiodentechnik herkömmlich verwendeten Epoxid-, Silikon- oder Acrylatharz oder aus einem anderen geeigneten strahlungsdurchlässigen Material wie z. B. anorganisches Glas.

Auf diese transparente Umhüllung 15 ist eine Schicht 4 aufgebracht, die aus einer wellenlängenkonvertierenden Vergußmasse, wie in der Figur 2 dargestellt, die gesamte Oberfläche der Umhüllung 15 bedeckt. Ebenso denkbar ist, daß die Schicht 4 nur einen Teilbereich dieser Oberfläche bedeckt. Die Schicht 4 besteht beispielsweise aus einem transparenten Epoxidharz, das mit Leuchtstoffpartikeln 6 versetzt ist. Auch hier eignet sich als Leuchtstoff für ein weiß leuchtendes Halbleiterbauelement bevorzugt YAG:Ce.

Bei dem in Figur 3 dargestellten besonders bevorzugten mit der erfindungsgemäßen Vergußmasse versehenen Bauelement, sind der erste und zweite elektrische Anschluß 2,3 in ein lichtundurchlässiges evtl. vorgefertigtes Grundgehäuse 8 mit einer Ausneh-5 mung 9 eingebettet. Unter "vorgefertigt" ist zu verstehen, daß das Grundgehäuse 8 bereits an den Anschlüssen 2,3 beispielsweise mittels Spritzguß fertig ausgebildet ist, bevor der Halbleiterkörper auf den Anschluß 2 montiert wird. Das Grundgehäuse 8 besteht beispielsweise aus einem lichtundurchlässigen Kunst-10 stoff und die Ausnehmung 9 ist hinsichtlich ihrer Form als Reflektor 17 für die vom Halbleiterkörper im Betrieb ausgesandte Strahlung (ggf. durch geeignete Beschichtung der Innenwände der Ausnehmung 9) ausgebildet. Solche Grundgehäuse 8 werden insbesondere bei auf Leiterplatten oberflächenmontierbaren Leuchtdi-15 oden verwendet. Sie werden vor der Montage der Halbleiterkörper auf ein die elektrischen Anschlüsse 2,3 aufweisendes Leiterband (Leadframe) z. B. mittels Spritzgießen aufgebracht.

Die Ausnehmung 9 ist mit einer Vergußmasse 5, deren Zusammensetzung der oben in Verbindung mit der Beschreibung zu Figur 1 angegebenen entspricht, gefüllt.

In Figur 4 ist eine sogenannte Radialdiode dargestellt. Hierbei ist der elektrolumineszierende Halbleiterkörper 1 in einem als Reflektor ausgebildeten Teil 16 des ersten elektrischen Anschlußes 2 beispielsweise mittels Löten oder Kleben befestigt. Derartige Gehäusebauformen sind in der Leuchtdiodentechnik bekannt und bedürfen von daher keiner näheren Erläuterung.

30

25

Die freien Oberflächen des Halbleiterkörpers 1 sind unmittelbar von einer Vergußmasse 5 mit Leuchtstoffpartikel 6 bedeckt, die wiederum von einer weiteren transparenten Umhüllung 10 umgeben ist.

Der Vollständikeit halber sei an dieser Stelle angemerkt, daß selbstverständlich auch bei der Bauform nach Figur 4 analog zu dem Bauelement gemäß Figur 1 eine einstückige Umhüllung, bestehend aus gehärteter Vergußmasse 5 mit Leuchtstoffpartikel 6, verwendet sein kann.

Bei dem Ausführungsbeispiel von Figur 5 ist eine Schicht 4 (mögliche Materialien wie oben angegeben) direkt auf den Halbleiterkörper 1 aufgebracht. Dieser und Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse 2,3 sind von einer weiteren transparenten Umhüllung 10 umschlossen, die keine Wellenlängenänderung der durch die Schicht 4 hindurchgetretenen Strahlung bewirkt und beispielsweise aus einem in der Leuchtdiodentechnik verwendbaren transparenten Epoxidharz oder aus Glas gefertigt ist.

10

15

20

25

30

Solche, mit einer Schicht 4 versehenen Halbleiterkörper 1 ohne Umhüllung können natürlich vorteilhafterweise in sämtlichen aus der Leuchtdiodentechnik bekannten Gehäusebauformen (z.B. SMD-Gehäuse, Radial-Gehäuse (man vergleiche Figur 4) verwendet sein.

Bei sämtlichen der oben beschriebenen Bauelemente kann zur Optimierung des Farbeindrucks des abgestrahlten Lichts sowie zur Anpassung der Abstrahlcharakteristik die Vergußmasse 5, ggf. die transparente Umhüllung 15, und/oder ggf. die weitere transparente Umhüllung 10 lichtstreuende Partikel, vorteilhafterweise sogenannte Diffusoren aufweisen. Beispiele für derartige Diffusoren sind mineralische Füllstoffe, insbesondere CaF₂, TiO₂, SiO₂, CaCO₃ oder BaSO₄ oder auch organische Pigmente. Diese Materialien können auf einfache Weise Epoxidharzen zugesetzt werden.

In den Figuren 6, 7 und 8 sind Emissionsspektren eines blaues Licht abstrahlenden Halbleiterkörpers (Fig. 6)

35 (Lumineszenzmaximum bei $\lambda \sim 430$ nm) bzw. von mittels eines sol-

chen Halbleiterkörpers hergestellten Weiß leuchtenden Halbleiterbauelementen (Fig. 7 und 8) gezeigt. An der Abszisse ist jeweils die Wellenänge λ in nm und auf der Ordinate ist jeweils eine relative Elektrolumineszenz(EL)-Intensität aufgetragen.

Von der vom Halbeiterkörper ausgesandten Strahlung nach Figur 6 wird nur ein Teil in einen längerwelligen Wellenlängenbereich konvertiert, so daß als Mischfarbe weißes Licht entsteht. Die gestrichelte Linie 30 in Figur 7 stellt ein Emissionsspektrum von einem Halbleiterbauelement dar, das Strahlung aus zwei komplementären Wellenlängenbereichen (Blau und Gelb) und damit insgesamt weißes Licht aussendet. Das Emissionsspektrum weist hier bei Wellenlängen zwischen ca. 400 und ca. 430 nm (Blau) und zwischen ca. 550 und ca. 580 nm (Gelb) je ein Maximum auf. Die durchgezogene Linie 31 repräsentiert das Emissionsspektrum eines Halbleiterbauelements, das die Farbe Weiß aus drei Wellenlängenbereichen (additives Farbtripel aus Blau, Grün und Rot) mischt. Das Emissionsspektrum weist hier beispielsweise bei den Wellenlängen von ca. 430 nm (Blau), ca. 500 nm (Grün) und ca. 615 nm (Rot) je ein Maximum auf.

Figur 8 zeigt ein Emissionsspektrum eines Weiß leuchtendes Halbleiterbauelement, das mit einem ein Emissions-Spektrum gemäß Figur 6 aussendenden Halbleiterkörper versehen ist und bei dem als Leuchtstoff YAG:Ce verwendet ist. Von der vom Halbeiterkörper ausgesandten Strahlung nach Figur 6 wird nur ein Teil in einen längerwelligen Wellenlängenbereich konvertiert, so daß als Mischfarbe weißes Licht entsteht. Die verschiedenartig gestrichelten Linien 30 bis 33 von Figur 8 stellen Emissionsspektren von erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementen dar, bei denen das Epoxidharz der Vergußmasse 5 unterschiedliche YAG:Ce-Konzentrationen aufweist. Jedes Emissionsspektrum weist zwischen λ = 420 nm und λ = 430 nm, also im blauen Spektralbereich, und zwischen λ = 520 nm und λ = 545 nm, also im grünen Spektralbereich, jeweils ein Intensitätsmaximum auf, wobei die

17

Emissionsbanden mit dem längerwelligen Intensitätsmaximum zu einem großen Teil im gelben Spektralbereich liegen. Das Diagramm von Figur 12 verdeutlicht, daß bei dem erfindungsgemäßen Halbleiterbauelement auf einfache Weise durch Veränderung der Leuchtstoffkonzentration im Epoxidharz der CIE-Farbort des weißen Lichtes verändert werden kann.

5

10

Die Erläuterung der Erfindung anhand der oben beschriebenen Bauelemente ist natürlich nicht als Beschränkung der Erfindung auf diese zu betrachten. Als Halbleiterkörper, wie beispiels-weise Leuchtdioden-Chips oder Laserdioden-Chips, ist beispiels-weise auch eine Polymer-LED zu verstehen, die ein enstprechendes Strahlungsspektrum aussendet.

Patentansprüche

- 1. Wellenlängenkonvertierende Vergußmasse (5) auf der Basis eines transparenten Epoxidgießharzes, das mit einem Leuchtstoff versetzt ist, für ein elektrolumineszierendes Bauelement mit einem ultraviolettes, blaues oder grünes Licht aussendenden Körper (1),
- dadurch gekennzeichnet, daß im transparenten Epoxidgießharz ein anorganisches Leuchtstoffpigmentpulver mit Leuchtstoffpigmenten (6) aus der Gruppe der Phosphore mit der allgemeinen Formel $A_3B_5X_{12}$:M dispergiert ist und daß die Leuchtstoffpigmente Korngrößen \leq 20 μ m und einen mittleren Korndurchmesser $d_{50} \leq$ 5 μ m aufweisen.
- 2. Vergußmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leuchtstoffpigmente (6) kugelförmig oder schuppenförmig sind.
- 3. Vergußmasse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 20 zeichnet, daß der mittlere Korndurchmesser d_{50} der Leuchtstoffpigmente (6) zwischen 1 und 2 μm liegt.
 - 4. Vergußmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergußmasse (5) zusammengesetzt ist aus:
 - a) Epoxidgießharz ≥ 60 Gew%

- b) Leuchtstoffpigmente > 0 und ≤ 25 Gew%
- c) Thixotropiermittel > 0 und ≤ 10 Gew%
- d) mineralischem Diffusor > 0 und ≤ 10 Gew%
- 30 e) Verarbeitungshilfsmittel > 0 und ≤ 3 Gew%
 - f) Hydrophobiermittel > 0 und ≤ 3 Gew%
 - q) Haftvermittler > 0 und ≤ 2 Gew%.

- 5. Vergußmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Leuchtstoffpigmente Partikel aus der Gruppe der Ce-dotierten Granate verwendet sind.
- 5 6. Vergußmasse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Leuchtstoffpigmente YAG:Ce-Partikel verwendet sind.
- 7. Vergußmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch 10 gekennzeichnet, daß deren Eisengehalt ≤ 20ppm ist.

15

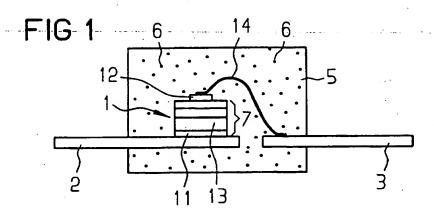
30

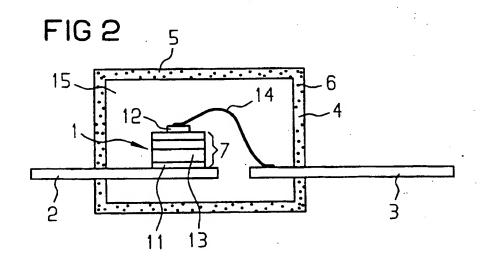
- 8. Vergußmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Leuchtstoffpigmente (6) mit einem Silikon-Coating versehen sind.
- 9. Verfahren zum Herstellen einer Vergußmasse gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Leuchtstoffpigmentpulver vor dem Vermischen mit dem Epoxidgießharz bei einer Temperatur ≥ 200°C getempert wird.
- 10. Verfahren zum Herstellen einer Vergußmasse gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Leuchtstoffpigmentpulver vor dem Vermischen mit dem Epoxidgießharz in einem höher siedenden Alkohol geschlämmt und anschließend getrocknet wird.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß dem Leuchtstoffpigmentpulver vor dem Vermischen mit dem Epoxidgießharz ein hydrophobierendes Silikonwachs
 zugegeben wird.
 - 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Leuchstoffpigmentpulver mit Alkoholen, Glykolethern und Silikonen im Epoxidgießharz bei erhöhten Temperaturen oberflächenmodifiziert wird.

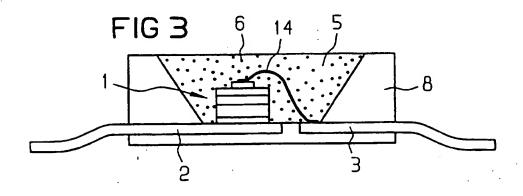
- 13. Verwendung der Vergußmasse nach einem der Ansprüche 1 bis 12 in einem lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterkörper (1), der im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische Strahlung aussendet dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (1) eine Halbleiterschichtenfolge (7) aufweist, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische Strahlung aus dem ultravioletten, blauen und/oder grünen Spektralbereich auszusenden, 10 daß die Leuchtstoffpigmente einen Teil der aus diesem Spektralbereich stammenden Strahlung in Strahlung mit größerer Wellenlänge umwandelt, derart, daß das Halbleiterbauelement Mischstrahlung, insbesondere mischfarbiges Licht, bestehend aus dieser Strahlung und aus Strahlung aus dem ultravioletten, blauen 15 und/oder grünen Spektralbereich aussendet.
- 14. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergußmasse zumindest einen Teil des Halbleiterkörpers (1) umschließt.
 - 15. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 13 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die vom Halbleiterkörper (1) ausgesandte Strahlung im blauen Spektralbereich bei λ = 430 nm oder bei λ = 450 nm ein Lumineszenz-Intentsitätsmaximum aufweist.
- 16. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der
 30 Halbleiterkörper (1) in einer Ausnehmung (9) eines lichtundurchlässigen Grundgehäuses (8) angeordnet ist und daß die Ausnehmung (9) zumindest teilweise mit der Vergußmasse (5) gefüllt.

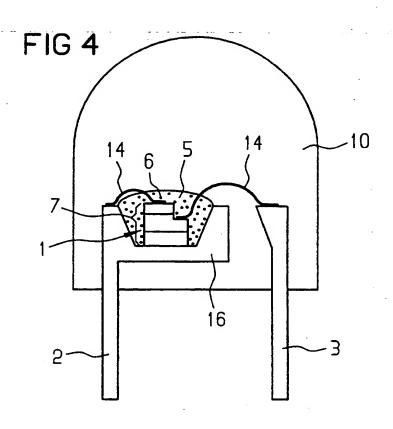
21

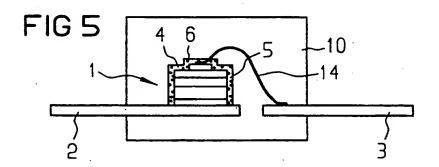
17. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergußmasse (5) hinsichtlich Wirtsgitter und Art und Ausmaß der Dotierung mit verschiedenartigen Leuchtstoffpigmenten (6) versehen ist.

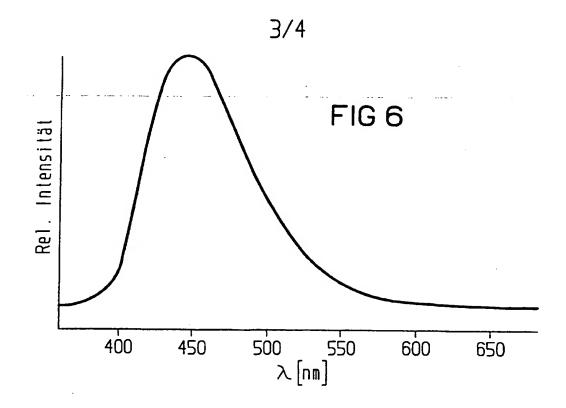


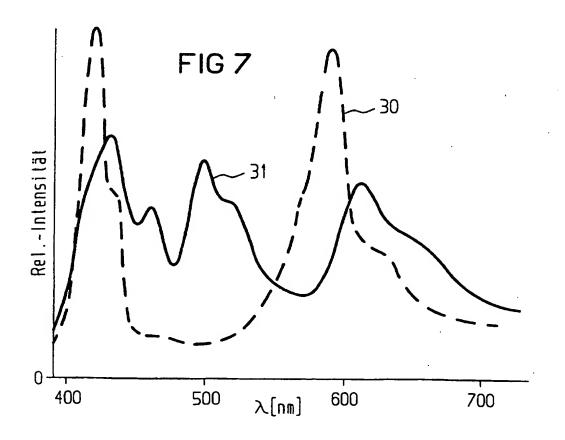


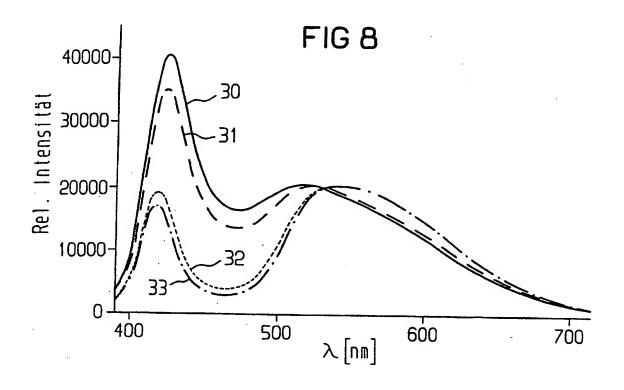












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter anal Application No PCT/DE 97/02139

	IOATION OF SUBJECT MATTER					
IPC 6	ICATION OF SUBJECT MATTER H01L33/00 H01S3/19					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS S	SEARCHED					
Minimum doo	sumentation searched (classification system followed by classification ${\tt s}$ ${\tt H01L}$	ymbola)	·			
Tre o	HOIC					
Desimontati	on searched other than minimum documentation to the extent that such	documents are included in the fields seal	rched			
Оосшинкам	orr searched out of the first management of the search of					
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base of	and, where practical, search terms used)				
•						
C DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	nt passages	Relevant to claim No.			
231		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Α	DE 90 13 615 U (LICENTIA		1,13			
	PATENT-VERWALTUNGS-GMBH) 6 Decembe	r 1990				
	see the whole document					
Α	DE 38 04 293 A (PHILIPS PATENTVERW	IALTUNG)	1,13			
	24 August 1989					
ļ	cited in the application					
		· ·				
			·			
			1			
			·			
Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are tisted	in annex.			
* Special c	ategories of cited documents :	The last of a supplied and a flor than inte	amentanal liling data			
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the						
cons	considered to be of particular relevance considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention					
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or						
which is cited to establish the publication date of another which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the						
"O" docur	"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such document.					
"P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
	Date of the actual completion of theirsternational search Date of mailing of the international search report					
	23 February 1998	03/03/1998				
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer				
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk					
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	De Laere, A				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No PCT/DE 97/02139

	Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
	DE 9013615 U	06-12-90	NONE	
-	DE 3804293 A	24-08-89	NONE	·

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte onales Aktenzeichen

	<u> </u>	1 20	1/DE 9//02139	1	
A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L33/00 H01S3/19				
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla				
i .	RCHIERTE GEBIETE	Bairikation und derIPK	and the second of the second o		
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)			
IPK 6	H01L				
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffantlichungen, so	weit diese unter die recherchi	erten Gebiete fatten		
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evti	. verwendete Suchbegriffe)		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		·		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden	Telle Betr. Anspruch Nr.		
			John Mapriculture		
A	DE 90 13 615 U (LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH) 6.Dezemb siehe das ganze Dokument	1,13			
A	DE 38 04 293 A (PHILIPS PATENTVER 24.August 1989 in der Anmeldung erwähnt	1,13			
Weitere Veröffentlächungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sintnehmen					
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik deltniert, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist oder dem Prioritäteatum veröffentlicht worden ist anderen in Recherchenbericht genannten Veröffentlichung zugrundellegenden Prinzips oder der int zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Beautzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist (wie dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichung die vor dem internationalen Anmeldedatum anderen der dem internationalen Anmeldedatum anderen internationalen Anmeldedatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum einer anderen Prioritätsdatum veröffentlichtung, die vor der dem Prioritätsdatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum einer anderen Prioritätsdatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum einer anderen Prioritätsdatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum einer anderen Prioritätsdatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum einer anderen Prioritätsdatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum einer anderen Prioritätsdatum veröffentlichtung die veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum einer anderen Prioritätsdatum veröffentlichtung, die veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erf					
Datum des A	bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des inter	nationalen Recherchenberichts		
	3.Februar 1998	03/03/1998			
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tet. (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (431-70) 340-3016	Bevolmächtigter Bedien: De Laere,			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte onales Aktenzeichen
PCT/DE 97/02139

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 9013615 U	06-12-90	KEINE	
DE 3804293 A	24-08-89	KEINE	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.